(11) 時況来早

	481)] (3r)	(12)	14 81		(62)	特許第6462904号 (P6462904)			
(45)発行日	平成31年	1月30日(2019.1.30)			(24) 登録日	平成31年1月11日	∃ (2019.1.11)		
(51) Int.Cl.			FI						
GO1P	5/00	(2006.01)	G O 1 P	5/00	G				
A 6 1 B	5/02	<b>(200</b> 6.01)	A 6 1 B	5/02	310B				
A61B	5/026	<b>(200</b> 6.01)	A 6 1 B	5/026	120				
A61B	5/0 <b>28</b> 5	(2006.01)	A 6 1 B	5/0285	Н				
G01P	5/ <b>2</b> 6	<b>(2006</b> .01)	G O 1 P	5/26	А				
						請求項の数 6	(全 16 頁)		
(21) 出願番号	3	特願2017-563705 (P20.	17-563705)	(73)特許権者 000006633					
(86) (22) 出原	面日	平成28年11月10日 (20)	16.11.10)		京セラ株式会	≷社			
(86) 国際出願	顧番号	PCT/JP2016/083434			京都府京都市	5伏見区竹田鳥羽縣	段町6番地		
(87) 国際公開	靜番号	W02017/130520		(72)発明者	大出 泰				
(87) 国際公開	目	平成29年8月3日(2017	.8.3)		京都府京都市	5伏見区竹田鳥羽脉	段町6番地		
審査請求	マロ	平成30年5月14日 (2013	8.5.14)		京セラ株式会	社内			
(31) 優先権主	E張番号	特願2016-11937 (P2010	6-11937)	(72)発明者	伊藤 宏樹				
(32) 優先日		平成28年1月25日 (2010	6.1.25)		京都府京都市	5伏見区竹田鳥羽/	段町6番地		
(33) 優先権主	E張国	日本国(JP)			京セラ株式会	≹社内			
				(72)発明者	杉本 好正				
					京都府京都市	5伏見区竹田鳥羽縣	段町6番地		
					京セラ株式会	社内			
				∥(72)発明者	新納 範高				
					京都府京都市	5伏見区竹田鳥羽縣	段町6番地		
					京セラ株式会	≹社内			
						最後	8百に続く		

(1)) **杜 社 小 却(R)**)

(54) 【発明の名称】計測センサ用パッケージおよび計測センサ

(57)【特許請求の範囲】

(10)日本国特教庁(10)

【請求項1】

複数の誘電体層が積層されて成る、矩形板状の基体であって、発光素子を収容する第1 収容凹部および受光素子を収容する第2収容凹部が、第1面に設けられており、前記第1 収容凹部は、前記発光素子を実装する第1底面を含み、前記第1収容凹部の内側面に、前 記第1面の面方向に延びる第1段差面を有する第1段差部が設けられ、該第1段差面上に 、前記発光素子と電気的に接続される第1接続パッドが配設され、前記第2収容凹部は、 前記受光素子を実装する第2底面を含み、前記第2収容凹部の内側面に、前記第1面の面 方向に延びる第2段差面を有する第2段差部が設けられ、該第2段差面上に、前記受光素 子と電気的に接続される第2接続パッドが配設され、平面視で、前記第1底面の中心と前 記第2底面の中心とを結ぶ方向において、前記第1段差面が、前記第1底面よりも外方に 位置しているとともに、前記第2段差面が、前記第2底面よりも外方に位置している基体 、を含む計測センサ用パッケージ。

【請求項2】

前記第1収容凹部および前記第2収容凹部を覆う、絶縁材料を含む板状の蓋体であって、前記第1収容凹部に収容される前記発光素子から出射される光が透過し、前記第2収容 凹部に収容される前記受光素子が受光する光が透過する蓋体と、

該蓋体の、前記第1収容凹部および前記第2収容凹部に対向する側の主面に配設される、接地電位に接続される接地導体層であって、前記発光素子から出射される光が通過する 第1開口および前記受光素子によって受光される光が通過する第2開口が設けられている

接地導体層と、をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の計測センサ用パッケージ。

前記基体の厚み方向において、前記第1接続パッドと前記接地導体層との間の距離が、

【請求項3】

前記第2接続パッドと前記接地導体層との間の距離よりも小さいことを特徴とする請求項 1または2に記載の計測センサ用パッケージ。 【請求項4】 前記第1段差面の面積が、前記第2段差面の面積よりも小さいことを特徴とする請求項 1~3のいずれかに記載の計測センサ用パッケージ。 【請求項5】 10 平面視で、前記第2接続パッドの面積が、前記第1接続パッドの面積よりも大きいこと を特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の計測センサ用パッケージ。 【請求項6】 請求項1~5のいずれか1つに記載の計測センサ用パッケージと、 前記第1 収容凹部に収容される発光素子と、 前記第2収容凹部に収容される受光素子と、を含むことを特徴とする計測センサ。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 [0001]本発明は、計測センサ用パッケージおよび計測センサに関する。 20 【背景技術】 [0002]血流等の生体情報を簡単に、かつ高速に測定できる計測センサが求められている。例え ば血流は、光のドップラー効果を利用して計測することができる。血液に光を照射すると 赤血球等の血球細胞で光が散乱される。照射光の周波数と散乱光の周波数とから血球細 胞の移動速度が算出される。 [0003]血流を計測する計測センサは、例えば、特許文献1に自発光型計測センサとして記載さ れており、基板上に、血液に光を照射する照射部と散乱光を受光する受光部とが配置され 、各々を取り囲む遮光性の接着部によって基板に前面板が接着されている。 30 [0004]血流の計測等に用いられる計測センサでは、計測センサの内部で発生した不要な電磁波 が、信号配線導体に進入してノイズを発生させ、このノイズの影響により測定精度が低下 する。 【先行技術文献】 【特許文献】 [0005]【 特 許 文 献 1 】 特 許 第 5 0 3 1 8 9 5 号 公 報 【発明の概要】 [0006]40 本発明の一つの態様の計測センサ用パッケージは、複数の誘電体層が積層されて成る、 矩形板状の基体を含む。前記基体は、発光素子を収容する第1収容凹部および受光素子を 収容する第2収容凹部が、第1面に設けられている。前記第1収容凹部は、前記発光素子 を実装する第1底面を含む。前記第1収容凹部の内側面に、前記第1面の面方向に延びる 第1段差面を有する第1段差部が設けられ、該第1段差面上に、前記発光素子と電気的に 接続される第1接続パッドが配設されている。前記第2収容凹部は、前記受光素子を実装 する第2底面を含む。前記第2収容凹部の内側面に、前記第1面の面方向に延びる第2段 差面を有する第2段差部が設けられ、該第2段差面上に、前記受光素子と電気的に接続さ れる第2接続パッドが配設されている。平面視で、前記第1底面の中心と前記第2底面の 中心とを結ぶ方向において、前記第1段差面が、前記第1底面よりも外方に位置している とともに、前記第2段差面が、前記第2底面よりも外方に位置している。 50 [0007]

また、本発明の一つの態様の計測センサは、上記の計測センサ用パッケージと、前記第 1 収容凹部に収容される発光素子と、前記第2 収容凹部に収容される受光素子と、を含む

【図面の簡単な説明】

【 0 0 0 8 】

本発明の目的、特色、および利点は、下記の詳細な説明と図面とからより明確になるであろう。

【図1】本発明の実施形態に係る計測センサ用パッケージ1を示す平面図である。

【図2】図1の切断面線A-Aで切断した断面図である。

【図3】図1の切断面線B-Bで切断した断面図である。

【図4】図2に示した断面図に対応する計測センサ用パッケージ1Aの断面図である。

【図5】図3に示した断面図に対応する計測センサ用パッケージ1Aの断面図である。

【図6】計測センサ100の構成を示す断面図である。

【図7】実施例および比較例におけるクロストーク量のシミュレーション結果を示す図で ある。

【図8】実施例および比較例の評価結果を示す図である。

【発明を実施するための形態】

[0009]

図1は、本発明の実施形態に係る計測センサ用パッケージ1を示す平面図であり、図2 20 は、図1の切断面線A-Aで切断した断面図であり、図3は、図1の切断面線B-Bで切 断した断面図である。なお、図1の平面図では、蓋体3、接地導体層4、および信号配線 導体23を省略して図示している。

[0010]

計測センサ用パッケージ1は、発光素子および受光素子を収容する基体2を含む。

【 0 0 1 1 】

本実施形態の基体2は、矩形板状であって、複数の誘電体層が積層されて形成されている。また、この基体2には、少なくとも2つの凹部が設けられている。2つの凹部のうちの一方は、発光素子を収容する第1収容凹部20aであり、2つの凹部のうちの他方は、受光素子を収容する第2収容凹部20bである。第1収容凹部20aおよび第2収容凹部20bは、基体2の第1面(一方主面)20cに開口するように設けられている。 【0012】

第1 収容凹部20 a は、発光素子を実装する第1底面20 d を含む。第1 収容凹部20 aの内側面に、一方主面20 c の面方向に延びる第1段差面20 f を有する第1段差部2 0 h が設けられる。第1段差面20 f 上には、発光素子と電気的に接続される第1接続パ ッド23 a が配設される。第2 収容凹部20 b は、受光素子を実装する第2底面20 e を 含む。第2 収容凹部20 b の内側面に、一方主面20 c の面方向に延びる第2段差面20 g を有する第2段差部20 i が設けられる。第2段差面20 g 上には、受光素子と電気的 に接続される第2接続パッド23 b が配設される。

[0013]

本実施形態では、平面視で、第1底面20dの中心c1と第2底面20eの中心c2と を結ぶ方向において、第1段差面20fが第1底面20dよりも外方に位置しており、第 2段差面20gが第2底面20eよりも外方に位置している。本実施形態では、図1に示 すように、平面視したときに、第1底面20dの中心c1と第1段差面20fの中心c3 とを結ぶ方向が、第1底面20dの中心c1と第2底面20eの中心c2とを結ぶ方向に 一致しているが、第1底面20dの中心c1と第1段差面20fの中心c3とを結ぶ方向 と、第1底面20dの中心c1と第2底面20eの中心c2とを結ぶ方向とは一致してい なくてもよい。また、本実施形態では、図1に示すように、平面視したときに、第2底面 20eの中心c2と第2段差面20gの中心c4とを結ぶ方向が、第1底面20dの中心 c1と第2底面20eの中心c2とを結ぶ方向に一致しているが、第2底面20eの中心 30

10

c2と第2段差面20gの中心c4とを結ぶ方向と、第1底面20dの中心c1と第2底 面20eの中心c2とを結ぶ方向とは一致していなくてもよい。 【0014】

(4)

このように、第1接続パッド23 a が配設される第1段差面20f、および第2接続パ ッド23 b が配設される第2段差面20gを設けることによって、計測センサの内部で発 生した不要な電磁波が、第1接続パッド23 a および第2接続パッド23 b に進入して、 ノイズを発生させることを抑制することができる。特に、血流の計測等に用いられる計測 センサでは、受光素子による受光量が比較的小さく、受光素子から出力される受光信号は 弱いので、発光素子の駆動信号から発生する電磁波が受光素子の受光信号に混入する電気 的なクロストークが、ノイズを発生させる原因となる。特に、計測センサ用パッケージと 受光素子とを電気的に接続するための接続パッドは、通常、大きな表面積を有するので、 発光素子の駆動信号から発生する電磁波が進入し易い。本実施形態では、平面視で、第1 底面20 d の中心c1と第2底面20 e の中心c2とを結ぶ方向において、第1接続パッ ド23 a が配設される第1段差面20 f、および第2接続パッド23 b が配設される第2 段差面20 g が外方に配置される。これにより、本実施形態の計測センサ用パッケージ1 を備える計測センサは、発光素子の駆動信号から発生する電磁波が受光素子の受光信号に 混入する電気的なクロストークを抑制し、高精度の計測を行うことができる。

また、自発光型の計測センサでは、発光素子から出射される光が、被計測物によって散 乱されて、受光素子に至るまでの光路長が短くなるほど、受光素子が受光する被計測物か らの散乱光の光量が増加する。本実施形態の計測センサ用パッケージ1を備える計測セン サでは、発光素子と受光素子とが内方に配置されるので、発光素子と受光素子との間の光 路長を短くして、計測センサの感度を向上させることが可能になる。

【0016】

さらに、本実施形態の計測センサ用パッケージ1を備える計測センサでは、平面視したと きに、発光素子と受光素子との間に光を遮断する十分な厚みの遮光壁が設けられ、かつ発 光素子と受光素子とが遮光壁に近接して配置された構造とすることが可能になるので、発 光素子の光を受光素子が直接受光することによる光学的クロストークを抑制することが可 能になる。

【0017】

本実施形態における第1収容凹部20a、および第2収容凹部20bは、開口形状が、 例えば、円形状、正方形状、矩形状等であってもよく、その他の形状であってもよい。第 1収容凹部20aの開口は、例えば縦方向長さが0.3mm~1.5mmであり、横方向 長さが0.3mm~2.0mmである。また、第2収容凹部20bの開口は、例えば縦方 向長さが0.5mm~2.0mmであり、横方向長さが0.5mm~2.5mmである。 基体2の厚み方向において、第1収容凹部20a深さと第2収容凹部20bの深さとは、 同じ深さであってもよく、異なる深さであってもよい。図1~図3に示す実施形態では、 第1収容凹部20aの深さを、第2収容凹部20bの深さよりも浅くしている。

【0018】

本実施形態の計測センサ用パッケージ1は、蓋体3および接地導体層4をさらに有する <sup>40</sup>

【0019】

蓋体3は、基体2の一方主面20cに接合されて、第1収容凹部20aおよび第2収容 凹部20bを覆う。蓋体3は、絶縁材料からなる板状部材である。蓋体3は、第1収容凹 部20aに収容される発光素子から出射される光が透過し、第2収容凹部20bに収容さ れる受光素子によって受光される光が透過するように構成される。

[0020]

本実施形態の計測センサ用パッケージ1を備える計測センサでは、蓋体3の表面に、例 えば被計測物である手指を当てた状態で発光素子から出射した光を照射する。蓋体3が導 電性を有する材料で構成されていると、蓋体3に手指を接触させたときに、指先に溜まっ 10

20

ていた不要な電荷が手指から放出され、蓋体3を通して基体2に電荷が流れ込みノイズが 発生する。蓋体3を絶縁材料で構成することにより、蓋体3を通して不要な電荷が流れ込 むことを抑制することができる。

(5)

[0021]

また、蓋体3は、被計測物への照射光および散乱光を透過する必要がある。照射光およ び散乱光の特性は、搭載する発光素子によって決まるので、少なくとも搭載する発光素子 が出射する光が透過するように構成されていればよい。蓋体3を構成する絶縁材料は、発 光素子から出射される光の波長に対して、当該波長の光の透過率が70%以上であっても よく、90%以上の透過率を有していることが好ましい。

[0022]

蓋体3を構成する絶縁材料としては、例えばサファイア等の透明セラミック材料、ガラ ス材料または樹脂材料等を用いることができる。ガラス材料としては、ホウケイ酸ガラス 、結晶化ガラス、石英、ソーダガラス等を用いることができる。樹脂材料としては、ポリ カーボネート樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂等を用いることができる。 [0023]

蓋体3は、手指等の被計測物が直接接触するため、所定の強度を要する。蓋体3の強度 は、構成する材料の強度、板厚みによる。上記のように透明セラミック材料やガラス材料 であれば、所定の厚み以上とすることで十分な強度が得られる。蓋体3の構成材料として ガラス材料を用いる場合は、例えば厚みを0.05mm~5mmとすればよい。

[0024]

接地導体層4は、蓋体3の、第1収容凹部20aおよび第2収容凹部20bに対向する 側の主面、すなわち手指が接触する側の主面とは反対側の主面に配設される。接地導体層 4は、接地電位に接続される。接地導体層4には、発光素子から出射される光が通過する 第1開口4aおよび受光素子が受光する光が通過する第2開口4bが設けられている。 [0025]

接地導体層4は、不要な光が第1収容凹部20aから外部に出射しないよう、また不要 な光が外部から第2収容凹部20bに進入しないように、第1開口4aおよび第2開口4 bが設けられたマスク部材として機能する。

[0026]

30 さらに、接地導体層4は、外部から到来する電磁波が第1収容凹部20aおよび第2収 容凹部20bに進入することを抑制するための電磁シールドとしても機能する。電磁波が 第1収容凹部20aおよび第2収容凹部20bに進入すると、例えば計測センサ用パッケ ージ1と発光素子および受光素子とを電気的に接続するボンディングワイヤがアンテナと なって進入した電磁波を受信してしまいノイズ発生の原因となる。蓋体3の主面に、光を 通過させるための第1開口4aおよび第2開口4bを除いて接地導体層4を設けることで 、電磁波の進入を抑制し、ノイズの発生を低減することができる。

[0027]

このように、蓋体3に接地導体層4を設けることで、ノイズによる影響を抑制し、計測 精度を向上させることができる。

[0028]

接地導体層4は、透明セラミック材料またはガラス材料からなる蓋体3の表面に、例え ば、Cr、Ti、A1、Cu、Co、Ag、Au、Pd、Pt、Ru、Sn、Ta、Fe 、In、Ni、Wなどの金属及びこれらの合金等の金属材料を蒸着、スパッタ、焼付け等 による金属薄膜として形成することができる。接地導体層4の層厚みは、例えば、500 ~ 4 0 0 0 である。接地導体層 4 は単一層でも良く、複数層を重ねて形成しても良い

[0029]

本実施形態の計測センサ用パッケージ1を備える計測センサでは、発光素子から出射さ れた光の一部は、接地導体層4によって反射され、第1段差面20fに向かう迷光となる 。第1段差面20fは、そのような迷光を外部に向かって再反射してしまう。このような 10

20

40

、第1段差面20fによる再反射は、計測センサの計測精度を悪化させる原因となる。本 実施形態では、第1段差面20fの面積を、第2段差面20gの面積に比べて小さくする ことによって、計測精度の悪化を抑制している。第1段差面20fおよび第2段差面20 gの形状は、例えば正方形状、矩形形状等であってもよく、その他の形状であってもよい 。第1段差面20fの大きさは、例えば縦方向長さが0.3mm~1.5mmであり、横 方向長さは0.1mm~1.0mmである。第2段差面20gの大きさは、例えば縦方向 長さが0.5mm~2.0mmであり、横方向長さは0.2mm~1.5mmである。 【0030】

血流の計測等に用いられる計測センサでは、受光素子による受光量が比較的小さく、受 光素子から出力される電気信号が弱い。受光素子側の信号配線導体の電気抵抗を小さくし て、受光素子から出力される電気信号の減衰を低減することによって、高精度の計測を行 うことができる。本実施形態では、平面視で、第2接続パッド23bの面積を、第1接続 パッド23aの面積に比べて大きくすることで、受光素子側の信号配線導体23の電気抵 抗を小さくしている。第1接続パッド23aおよび第2接続パッド23bの形状は、例え ば正方形状、矩形形状等であってもよく、その他の形状であってもよい。第1接続パッド 23aおよび第2接続パッド23bの形状は、第1段差面20fおよび第2段差面20g の全面を覆う構造であってもよく、一部を覆う構造であってもよい。第1接続パッド23 aの大きさは、例えば縦方向長さが0.1mm~1.5mmであり、横方向長さは0.1 mm~1.0mmである。第2接続パッド23bは、例えば縦方向長さが0.2mm~2

血流の計測等に用いられる計測センサでは、信号導体を伝送される電気信号が比較的弱 く、計測センサの内部に生じる寄生容量によって受ける影響が大きい。例えば、発光素子 側で生じる寄生容量と、受光素子側で生じる寄生容量との差が、計測精度を悪化させる原 因となる。本実施形態では、前述のように、平面視で、第2接続パッド23bの面積が第 1接続パッド23aの面積よりも大きい。そこで、本実施形態では、基体2の厚み方向に おける、第1接続パッド23aと接地導体層4との間の距離h1を、第2接続パッド23 bと接地導体層4との間の距離h2よりも小さくすることによって、接地導体層4と第1 接続パッド23aとの間に形成される寄生容量と、接地導体層4と第2接続パッド23b との間に形成される寄生容量との差を低減し、計測精度の悪化を抑制している。例えば、 h1は0.05mm~0.7mmであり、h2は0.1mm~1.2mmである。 【0032】

本実施形態では、基体2が、接地ビア導体21をさらに有する。接地ビア導体21は、 平面視で、基体2の、第1収容凹部20aおよび第2収容凹部20bよりも外方に配設さ れ、接地電位に接続される。接地ビア導体21は、基体2を構成する各誘電体層を厚み方 向に貫通する貫通導体が、基体2の厚み方向に複数連なって構成される。接地ビア導体2 1は、本実施形態では、例えば図2に示すように、基体2全体を厚み方向に貫通しており 、平面視では、各誘電体層に設けられる貫通導体の位置が同一である。すなわち、接地ビ ア導体21は、基体2の第1面(一方主面)20cから第1面とは反対側の第2面(他方 主面)にまで一直線状に貫通しており、接地ビア導体21の一方端面21aが、基体2の 一方主面20cに露出し、他方端面21bが、基体2の他方主面に露出している。 【0033】

接地ビア導体21の一方端面21aは、後述の環状接地導体層22を介して蓋体3に配設された接地導体層4に接続される。接地ビア導体21の他方端面21bは、基体2の他方主面に配設される外部接続端子24に接続される。このような接地ビア導体21によって、蓋体3に配設された接地導体層4、環状接地導体層22および接地ビア導体21には、電気的に接続され、同じ接地電位が与えられる。

[0034]

このような接地ビア導体21を設けることによって、計測センサ用パッケージ1を備え る計測センサで血流を計測する場合に、被計測物の一つである人の手指が計測センサに接 <sup>50</sup>

20

10

30

触したときに放出される電荷は、基体 2 の一方主面 2 0 c から接地ビア導体 2 1 を流れ、 基体 2 の第 2 面(他方主面)に到達し、外部へと放出される。 【 0 0 3 5 】

接地ビア導体21が設けられていない従来の構成では、人から放出された電荷は、発光 素子または受光素子と計測センサ用パッケージ1とを電気的に接続する接続体、例えばボ ンディングワイヤ等から信号配線導体に進入しノイズを引き起こす。 【0036】

本実施形態では、接地ビア導体21によって、人から放出された電荷が流れ易い経路を 計測センサ用パッケージ1内に形成することで、この経路に電荷を誘導して外部へと電荷 を逃がし、信号配線導体に進入することを防止している。

【0037】

本実施形態において、接地ビア導体21は、基体2の外形に沿って、配設される。基体2は、矩形状の外形を有するので、接地ビア導体21も、矩形状に沿って配設される。すなわち、基体2の外形線を構成する各辺から接地ビア導体21までの距離が同様の距離となるように、各接地ビア導体21が配設されている。図1の平面図においては、接地ビア導体21の配設位置を破線の円で示している。例えば、図2の断面図において示される3つの接地ビア導体21は、図1において、図面向かって上側に横方向に等間隔で並ぶ3つの接地ビア導体21であり、各接地ビア導体21の中心を結ぶ仮想直線が基体2の長辺に平行となるように配設されても同様であり、例えば、図1において、図面向かって左側に上下方向に並ぶ2つの接地ビア導体21は、中心を結ぶ仮想直線が基体2の短辺に平行となるように配設されており、図面向かって下側に横方向に並ぶ2つの接地ビア導体21は、中心を結ぶ仮想直線が基体2の長辺に平行となるように配設されている。

【0038】

本実施形態では、合計5つの接地ビア導体21が、第1収容凹部20aおよび第2収容 凹部20bよりも外方で、第1収容凹部20aおよび第2収容凹部20bを取り囲むよう に、かつ基体2の外形である矩形に沿って配設されている。矩形の4つの隅部のうち3つ の隅部には、接地ビア導体21がそれぞれ配設されており、残り1つの隅部には、配設さ れていない。

【0039】

接地ビア導体21の配設位置は、第1収容凹部20aとの距離および第2収容凹部20 bとの距離に基づいて決定されてもよい。前述のように、接地ビア導体21には、信号配 線導体に進入してしまうとノイズの原因となる不要な電荷が流れるので、接地ビア導体2 1と、計測センサ用パッケージ1に形成される信号配線導体23(基体2内およびボンデ ィングワイヤを含む)との距離を予め定める距離以上に大きくして、接地ビア導体21か ら信号配線導体23に不要な電荷が進入してしまうことを低減している。

【0040】

本実施形態で矩形の4つの隅部のうち、第1収容凹部20aまたは第2収容凹部20b との距離、言い換えれば信号配線導体23との距離が予め定める距離よりも小さくなる位 置には接地ビア導体21を設けなくてもよい。本実施形態において、1つの隅部に、接地 ビア導体21を設けていないのは、当該隅部と信号配線導体23との距離が予め定める距 離よりも小さいからである。

【0041】

接地ビア導体21は、上記のように不要な電荷を誘導してパッケージ外部に放出させる ために、電気抵抗を低くしてもよく、電気抵抗を低くするためには、直径をより大きくし てもよい。しかしながら、直径を大きくし過ぎると、信号配線導体との距離が小さくなり 、接地ビア導体21から信号配線導体に不要な電荷が進入するおそれがある。したがって 、これらを考慮して、例えば、接地ビア導体21の大きさは、直径Dが、10µm~50 0µmとすればよい。

【0042】

10

20

40

環状接地導体層22は、基体2の一方主面20cに、第1収容凹部20aの開口および 第2収容凹部20bの開口を取り囲むように環状に設けられる導体層である。この環状の 導体層は、基体2の一方主面20cに露出した接地ビア導体21の各一方端面21aを電 気的に接続する。環状接地導体層22は、蓋体3を基体2に接合するために、はんだ、A u-Sn、ろう材等の金属溶湯物系接合材、またはエポキシ系、シリコン系、熱可塑性樹 脂、異方性導電樹脂、導電性エポキシ樹脂、導電性シリコン樹脂等の樹脂系接合材によっ て接地導体層4と接合される。

[0043]

複数の接地ビア導体21は、基体2の外形である矩形に沿って配設されており、各一方 端面21aも基体2の外形である矩形に沿って、基体2の一方主面20cに露出している<sup>10</sup>。本実施形態では、図1に示すように、各一方端面21aを電気的に接続するための環状 接地導体層22も、これらの配置位置に応じて、矩形状に設けている。環状接地導体層2 2は、接地ビア導体21の一方端面21aと接続するランド部分22aと、各ランド部分 を接続する接続線部分22bとからなる。ランド部分22aは、接地ビア導体21の一方 端面21aと確実に、かつ低抵抗で接続するために、一方端面21aよりも大きく形成さ れている。例えば、接地ビア導体21の一方端面21aの直径Dに対して、ランド部分2 2aは、1×D~3×D(直径の1~3倍)の幅または直径を有する。接続線部分22b は、ランド部分22aよりも細く、一定の線幅に形成されている。 【0044】

信号配線導体23は、発光素子または受光素子と電気的に接続され、発光素子に入力さ 20 れる電気信号が伝送され、受光素子から出力される電気信号が伝送される。本実施形態に おける信号配線導体23は、発光素子または受光素子と接続する接続部材であるボンディ ングワイヤと、ボンディングワイヤが接続される第1接続パッド23aおよび第2接続パ ッド23bと、第1接続パッド23aおよび第2接続パッド23bに電気的に接続して接 続パッドの直下から基体2の他方主面にまで一直線状に延びる信号ビア導体23cと、外 部接続端子24とから成る。外部接続端子24は、計測センサ用パッケージ1を備える計 測センサが実装される外部実装基板の接続端子とはんだ等の接合材料によって電気的に接 続される。

【0045】

環状接地導体層22および外部接続端子24は、はんだ等の接合材との濡れ性を向上さ 30 せ、耐食性を向上させるために、例えば、厚さが0.5~10µmのニッケル層と厚さが 0.5~5µmの金層とをめっき法によって順次被着させてもよい。

[0046]

基体2は、発光素子および受光素子を収容可能であり、接地ビア導体21および信号配 線導体23等を備えるものであれば、基体2の誘電体層がセラミック絶縁材料からなり、 接地ビア導体21および信号配線導体23等が導体材料からなるセラミック配線基板であ ってもよく、誘電体層が樹脂絶縁材料からなる有機配線基板であってもよい。

【0047】

基体2が、セラミック配線基板の場合、セラミック材料から成る誘電体層に各導体が形成される。セラミック配線基板は、複数のセラミック誘電体層から形成される。 【0048】

セラミック配線基板で用いられるセラミック材料としては、例えば、酸化アルミニウム 質焼結体、ムライト質焼結体、炭化珪素質焼結体、窒化アルミニウム質焼結体、窒化珪素 質焼結体またはガラスセラミックス焼結体等が挙げられる。

【0049】

また、基体2が、有機配線基板の場合、有機材料から成る絶縁層に配線導体が形成される。有機配線基板は、複数の有機誘電体層から形成される。

【 0 0 5 0 】

有機配線基板は、例えば、プリント配線基板、ビルドアップ配線基板またはフレキシブ ル配線基板等の誘電体層が有機材料から成るものであればよい。有機配線基板で用いられ <sup>50</sup> る有機材料としては、例えば、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂またはフッ素系樹脂等が挙げられる。 【0051】

(9)

次に、本発明の他の実施形態について説明する。図4は、図2に示した断面図に対応する計測センサ用パッケージ1Aの断面図であり、図5は、図3に示した断面図に対応する 計測センサ用パッケージ1Aの断面図である。

【0052】

本実施形態の計測センサ用パッケージ1Aは、上記の実施形態の計測センサ用パッケージ1に対して、基体2が、さらに内部接地導体層25を有する点で異なっており、その他については、同様の構成であるので、同様の構成には計測センサ用パッケージ1と同じ参照符号を付して詳細な説明は省略する。

【0053】

内部接地導体層25は、接地電位に接続され、基体2の、第2収容凹部20bの底部と 他方主面との間に配設される。内部接地導体層25は、接地ビア導体21と、基体2の内 部において電気的に接続されており、接地電位が付与される。

【0054】

血流の計測等に用いられる計測センサでは、受光素子による受光量が比較的小さいので 、受光素子から出力される電気信号は弱く、発光素子に入力される発光制御用の電気信号 に比べてノイズによって受ける影響が大きい。

[0055]

計測センサは、外部実装基板上に実装されて使用されるが、この外部実装基板の配線を 流れる信号等に起因する電磁波が、基体2の他方主面側から計測センサ用パッケージ1内 に進入して、信号配線導体23を流れる信号にノイズが混入するおそれがある。

【0056】

上記のように、特に受光素子側は、ノイズの影響を大きく受けるので、外部実装基板からのノイズの影響を抑制するために、受光素子が収容される第2収容凹部20bの底部と 他方主面との間に内部接地導体層25を設けている。第2収容凹部20bと外部実装基板 との間に内部接地導体層25が位置し、電磁シールドとして機能する。

【0057】

本実施形態の計測センサ用パッケージ1Aは、内部接地導体層25を有することで、ノ <sup>30</sup> イズによる影響を抑制し、計測精度をさらに向上させることができる。 【0058】

計測センサ用パッケージ1の製造方法について説明する。まず、基体2を公知の多層配線基板の製造方法と同様にして作製する。基体2が、セラミック配線基板であり、セラミック材料がアルミナである場合は、まずアルミナ(A12O3)やシリカ(SiO2)、 カルシア(CaO)、マグネシア(MgO)等の原料粉末に適当な有機溶剤、溶媒を添加 混合して泥漿状とし、これを周知のドクターブレード法やカレンダーロール法等によって シート状に成形してセラミックグリーンシート(以下、グリーンシートともいう)を得る 。その後、グリーンシートを所定形状に打ち抜き加工するとともに、タングステン(W) とガラス材料等の原料粉末に有機溶剤、溶媒を添加混合して金属ペーストとし、これをグ リーンシート表面にスクリーン印刷等の印刷法でパターン印刷する。また、ビア導体は、 グリーンシートに貫通孔を設け、スクリーン印刷等によって金属ペーストを貫通孔に充填 させる。こうして得られたグリーンシートを複数枚積層し、これを約1600 の温度で 同時焼成することによって基体2が作製される。

【0059】

一方、ガラス材料を、切削、切断等により所定の形状に切り出した蓋体3を準備し、主面上に、蒸着、スパッタ、焼付け等によって金属薄膜からなる接地導体層4を形成する。 このとき、フォトリソグラフィ(ウェットエッチング)法、ドライエッチング法等によって金属薄膜にパターン加工することにより、第1開口4aおよび第2開口4bを形成する ことができる。 20

10

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ 

次に、本発明の他の実施形態である計測センサ100について説明する。図6は、計測 センサ100の構成を示す断面図である。計測センサ100は、上記の計測センサ用パッ ケージ1,1Aと、第1収容凹部20aに収容される発光素子30と、第2収容凹部20 bに収容される受光素子31と、を含む。発光素子30は、第1収容凹部20aの第1底 面20dに実装され、受光素子31は、第2収容凹部20bの第2底面20eに実装され る。計測センサ100は、ボンディングワイヤ32で、発光素子30と第1接続パッド2 3aとを接続し、受光素子31と第2接続パッド23bとを接続した後、蓋体3を基体2 に接合して得られる。

[0061]

発光素子30は、VCSEL等の半導体レーザ素子を用いることができ、受光素子31 は、シリコンフォトダイオード、GaAsフォトダイオード、InGaAsフォトダイオ ード、ゲルマニウムフォトダイオード等の各種フォトダイオードを用いることができる。 発光素子30および受光素子31は、被計測物の種類、計測するパラメータの種類等によ り適宜選択すればよい。

【0062】

血流を測定する場合は、例えば、光のドップラー効果を利用して測定するために、発光 素子30であるVCSELとして波長が850nmのレーザ光を出射可能なものであれば よい。その他の測定を行う場合は、測定目的に応じた波長のレーザ光を出射する発光素子 30を選択すればよい。受光素子31は、受光する光が発光素子30から出射されるレー ザ光から波長の変化が無い場合、発光素子30の出射光を受光できるものであればよく、 波長の変化が有る場合、変化後の波長の光を受光できるものであればよい。

20

10

【0063】

本実施形態では、例えば、ボンディングワイヤ32によって、発光素子30と第1接続 パッド23aとが電気的に接続され、受光素子31と第2接続パッド23bとが電気的に 接続されるが、フリップチップ接続、バンプ接続、異方性導電フィルムを用いた接続等他 の接続方法であってもよい。

[0064]

計測センサ100は、外部実装基板に実装されて使用される。外部実装基板には、例えば、発光素子30の発光を制御する制御素子、受光素子31の出力信号から血流速度等を 30 算出する演算素子等も実装される。

[0065]

測定する場合には、被計測物として手指の指先を蓋体3の表面に接触させた状態で、外 部実装基板から外部接続端子24を介して発光素子制御電流が計測センサ100に入力さ れ、信号ビア導体23c、第2接続パッド23bを通って発光素子30に入力されて発光 素子30から計測用の光が出射される。出射された光が、第1開口4aを通過し、蓋体3 を透過して指先に照射されると、血液中の血球細胞で散乱される。蓋体3を透過し、第2 開口4bを通過した散乱光が、受光素子31で受光されると、受光量に応じた電気信号が 受光素子31から出力される。出力された信号は、第1接続パッド23a、信号ビア導体 23cを通り、外部接続端子24を介して計測センサ100から外部実装基板へと出力さ れる。

【0066】

外部実装基板では、計測センサ100から出力された信号が、演算素子に入力され、例 えば、発光素子30から出射された光である照射光の周波数と、受光素子31が受光した 光である散乱光の周波数とに基づいて血流速度を算出することができる。

【0067】

なお、上記では、接地ビア導体21は、基体2内で上下方向に一直線状に形成される構成としているが、基体2の一方主面20cから他方主面の外部接続端子24まで電気的に 接続されていれば、一直線状でなく、基体2内で、内層配線や内部接地導体層25等によってずれて形成されていてもよい。

(11)

また、本実施形態において、環状接地導体層22は、必須構成ではなく、蓋体3に形成 された接地導体層4と接地ビア導体21とを直接接合して電気的に接続するように構成し てもよい。

[0069]

また、内部接地導体層25は、基体2の、第2収容凹部20bの底部と他方主面との間 からさらに面方向に延びて、第1収容凹部20aの底部と他方主面との間に配設されても よい。

【実施例】

[0070]

10

実施例1として、基体2の厚み方向において、第1収容凹部20aの深さと第2収容凹 部20bの深さとが等しく、かつ第1段差面20fと基体2の一方主面20cとの間の距 離と第2段差面20gと基体2の一方主面20cとの間の距離とが等しいこと以外は、図 1~図3に示した計測センサ用パッケージ1と同様の計測センサ用パッケージにおいて、 第1接続パッド23aと第2接続パッド23bとの間のクロストーク量をシミュレーショ ンによって算出した。第1接続パッド23aの形状は、縦方向長さを1.0mmとし、横 方向長さを0.5mmとした。第2接続パッド23bの形状は、縦方向長さを1.0mm とし、横方向長さを0.5mmとした。また、平面視で、第1接続パッド23aの中心と 第2接続パッド23bの中心との間の距離を3.0mmとした。さらに、第1収容凹部2 0aの深さと第2収容凹部20bの深さとを1.0mmに設定するとともに、基体2の厚 み方向において、第1段差面20fと基体2の一方主面20cとの間の距離と、第2段差 面20gと基体2の一方主面20cとの間の距離とを0.25mmに設定した。

本シミュレーションでは、計測センサ用パッケージ1の基体2、第1接続パッド23a 、および第2接続パッド23b以外の構成を省略するとともに、基体2は完全導体である とした。このような条件で、第1接続パッド23aと第2接続パッド23bとの間のクロ ストーク量の周波数依存性を算出した。具体的な算出方法は次のとおりである。第1接続 パッド23aに電圧信号を入力したときに第2接続パッド23bから出力される電圧信号 を算出し、入力した電圧信号の強度に対する出力された電圧信号の強度の比の対数に所定 の係数を乗算してクロストーク量とした。また、入力電圧の周波数を1kHz~20kH zの範囲で変化させることにより、クロストーク量の周波数依存性を算出した。本シミュ レーションでは、クロストーク量の絶対値が大きいほど、第1接続パッド23aと第2接続パッ ド23bとの電気的遮蔽が向上されており、第1接続パッド23aと第2接続パッ ド23bとの間の電気的なクロストークが抑制されていると判断することができる。 【0072】

また、比較例1として、平面視で、第1底面20dの中心c1と第2底面20eの中心 c2とを結ぶ方向において、第1段差面20fが第1底面20dよりも内方に位置してい るとともに、第2段差面20gが第2底面20eよりも内方に位置していること以外は、 実施例1の計測センサ用パッケージと同様の計測センサ用パッケージにおいて、実施例1 のシミュレーションと同じ条件で、第1接続パッド23aと第2接続パッド23bとの間 のクロストーク量の周波数依存性を算出した。比較例1では、平面視で、第1接続パッド 23aの中心と第2接続パッド23bの中心との間の距離を1.0mmとした。 【0073】

さらに、実施例2として、図1~図3に示した計測センサ用パッケージ1において、実施例1のシミュレーションと同じ条件で、第1接続パッド23aと第2接続パッド23b との間のクロストーク量の周波数依存性を算出した。実施例2では、第1収容凹部20a の深さを1.0mmに設定し、第2収容凹部20bの深さを2.0mmに設定するととも に、基体2の厚み方向において、第1段差面20fと基体2の一方主面20cとの間の距離と 離を0.25mmに設定し、第2段差面20gと基体2の一方主面20cとの間の距離と を0.75mmに設定した。 30

20

[0074]

また、比較例2として、平面視で、第1底面20dの中心c1と第2底面20eの中心 c2とを結ぶ方向において、第1段差面20fが第1底面20dよりも内方に位置してい るとともに、第2段差面20gが第2底面20eよりも内方に位置していること以外は、 実施例2の計測センサ用パッケージと同様の計測センサ用パッケージにおいて、実施例1 のシミュレーションと同じ条件で、第1接続パッド23aと第2接続パッド23bとの間 のクロストーク量の周波数依存性を算出した。比較例2では、平面視で、第1接続パッド 23aの中心と第2接続パッド23bの中心との間の距離を1.0mmとした。 【0075】

(12)

10 図7は、上記の実施例および比較例の結果を示す。図7(a)は、比較例1の結果を示 し、図7(b)は、実施例1の結果を示す。また、図7(c)は、比較例2の結果を示し 、図7(d)は、実施例2の結果を示す。図7(a)、図7(b)、図7(c)、および 図7(d)に示すように、実施例1、実施例2、比較例1、および比較例2のいずれにお いても、クロストーク量は入力電圧の周波数に依存しないという結果が得られた。この結 果は、本シミュレーションにおけるクロストーク量は、実質的に、基体2の内部に形成さ れる、第1接続パッド23aと第2接続パッド23bとの間の電気的経路の長さだけに依 存し、この電気的経路の長さが、1kHz~20kHzの周波数帯域の電圧信号について は、実質的に同一であったことに起因すると考えられる。また、図7( a )および図7( b)から、1kHz~20kHzの周波数帯域の全域で、実施例1におけるクロストーク 量が、比較例1におけるクロストーク量よりも小さくなっていることがわかる。さらに、 20 図 7 ( c ) および図 7 ( d ) から、 1 k H z ~ 2 0 k H z の周波数帯域の全域で、実施例 2におけるクロストーク量が、比較例2におけるクロストーク量よりも小さくなっている ことがわかる。

【 0 0 7 6 】

図8は、実施例1、実施例2、比較例1、および比較例2の評価結果を示す図である。 評価結果として、平均クロストーク量を用いた。平均クロストーク量は、1kHz~20 kHzの周波数帯域にわたるクロストーク量の平均値とする。平均クロストーク量が大き いほど電気的なクロストークが顕著であり、平均クロストーク量が小さいほど電気的なク ロストークが抑制されていると評価できる。

【0077】

図8に示すように、実施例1では、比較例1に比べて、平均クロストーク量が小さく、 電気的なクロストークが抑制されていると評価できる。また、実施例2では、比較例2に 比べて、平均クロストーク量が小さく、電気的なクロストークが抑制されていると評価で きる。さらに、実施例1は、比較例2に比べて、平均クロストーク量が小さい。すなわち 、第1接続パッド23aと第2接続パッド23bとの間における電気的なクロストークを 抑制するためには、平面視で、第1底面20dの中心c1と第2底面20eの中心c2と を結ぶ方向において、第1段差面20fを第1底面20dよりも外方に設け、第2段差面 20gを第2底面20eよりも外方に設けることが、第1収容凹部20aの深さを第2収 容凹部20bの深さよりも浅くすることよりも一層効果的であるといえる。

【0078】

上記のように、実施例1および実施例2では、平面視で、第1底面20dの中心c1と 第2底面20eの中心c2とを結ぶ方向において、第1段差面20fを第1底面20dよ りも外方に配置し、第2段差面20gを第2底面20eよりも外方に配置することにより 、発光素子側と受光素子側との間の電気的なクロストークが抑制されることがわかった。 【0079】

本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形態で実施できる。したがって、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示にすぎず、本発明の範囲は特許請求の範囲に示すものであって、明細書本文には何ら拘束されない。さらに、特許請求の範囲に属する変形や変更は全て本発明の範囲内のものである。

【符号の説明】

30

ľ	0	0	8	0	]										
	1				計	測	セ	ン	サ	用	パ	ッ	ケ	-	ジ
	1	A			計	測	セ	ン	サ	用	パ	ッ	ケ	-	ジ
	2				基	体									
	3				蓋	体									
	4				接	地	導	体	層						
	4	а			第	1	開	П							
	4	b			第	2	開	П							
	2	0	а		第	1	収	容	凹	部					
	2	0	b		第	2	収	容	凹	部					
	2	0	С		第	1	面								
	2	0	d		第	1	底	面							
	2	0	e		第	2	底	面							
	2	0	f		第	1	段	差	面						
	2	0	g		第	2	段	差	面						
	2	0	h		第	1	段	差	部						
	2	0	i		第	2	段	差	部						
	2	1			接	地	ビ	ア	導	体					
	2	1	а		—	方	端	面							
	2	1	b		他	方	端	面							
	2	2			環	状	接	地	導	体	層				
	2	2	а		ラ	ン	ド	部	分						
	2	2	b		接	続	線	部	分						
	2	3			信	号	配	線	導	体					
	2	3	а		第	1	接	続	パ	ツ	ド				
	2	3	b		第	2	接	続	パ	ツ	ド				
	2	3	С		信	号	ビ	ア	導	体					
	2	4			外	部	接	続	端	子					
	2	5			内	部	接	地	導	体	層				
	3	0			発	光	素	子							
	3	1			受	光	素	子							
	3	2			ボ	ン	デ	1	ン	グ	ワ	1	ヤ		
	1	0	0		計	測	セ	ン	サ						

10

20

【図1】

FIG. 1

【図2】 *FIG.2* 





【図3】 *F/G.3* 

【図4】 *FIG.4* 





【図5】

FIG. 5

【図6】 *FIG.6* 













フロントページの続き

- (72)発明者 松永 翔吾京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 京セラ株式会社内
- (72)発明者 林 拓也 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 京セラ株式会社内

## 審査官 森 雅之

(56)参考文献 特許第3882756(JP,B2) 特許第4475601(JP,B2) 特許第5031894(JP,B2)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 0 1 P 5 / 2 6 A 6 1 B 5 / 0 2 G 0 1 P 5 / 0 0 A 6 1 B 5 / 0 2 8 5

本件特許出願に対応する国際特許出願PCT/JP2016/083434の調査結果が利用された。